CMPSH-3E
CMPSH-3AE
CMPSH-3CE
CMPSH-3SE

ENHANCED SPECIFICATION
SURFACE MOUNT
SILICON SCHOTTKY DIODES

ENHANCED E SPECIFICATION

SOT-23 CASE

Central Semiconductor Corp.

www.centralsemi.com

DESCRIPTION:

The CENTRAL SEMICONDUCTOR CMPSH-3E Series types are Enhanced Versions of the CMPSH-3 Series of Silicon Schottky Diodes in an SOT-23 Surface Mount Package.

FEATURED ENHANCED SPECIFICATIONS:

- ♦ I_F from 100mA max to 200mA max.
- ♦ BV_R from 30V min to 40V min.
- ♦ V_F from 1.0V max to 0.8V max.

CMPSH-3E:	SINGLE	**MARKING CODE: D95E**
CMPSH-3AE:	DUAL, COMMON ANODE	**MARKING CODE: DB1E**
CMPSH-3CE:	DUAL, COMMON CATHODE	**MARKING CODE: DB2E**
CMPSH-3SE:	DUAL, IN SERIES	**MARKING CODE: DA5E**

MAXIMUM RATINGS: (T_A=25°C)	**SYMBOL**		**UNITS**
♦ **Peak Repetitive Reverse Voltage**	**V_{RRM}**	**40**	**V**
♦ **Continuous Forward Current**	**I_F**	**200**	**mA**
Peak Repetitive Forward Voltage	I_{FRM}	350	mA
Forward Surge Current, tp=10ms	I_{FSM}	750	mA
Power Dissipation	P_D	350	mW
Operating and Storage Junction Temperature	T_J, T_{stg}	-65 to +150	°C
Thermal Resistance	Θ_{JA}	357	°C/W

ELECTRICAL CHARACTERISTICS PER DIODE: (T_A=25°C unless otherwise noted)

SYMBOL	**TEST CONDITIONS**	**MIN**	**TYP**	**MAX**	**UNITS**
I_R	V_R=25V		90	500	nA
I_R	V_R=25V, T_A=100°C		25	100	µA
♦ **BV_R**	**I_R=100µA**	**40**	**50**		**V**
V_F	I_F=2.0mA		0.29	0.33	V
♦ **V_F**	**I_F=15mA**		**0.37**	**0.42**	**V**
♦ **V_F**	**I_F=100mA**		**0.61**	**0.80**	**V**
♦♦ **V_F**	**I_F=200mA**		**0.65**	**1.0**	**V**
C_T	V_R=1.0V, f=1.0MHz		7.0		pF
t_{rr}	I_F=I_R=10mA, I_{rr}=1.0mA, R_L=100Ω			5.0	ns

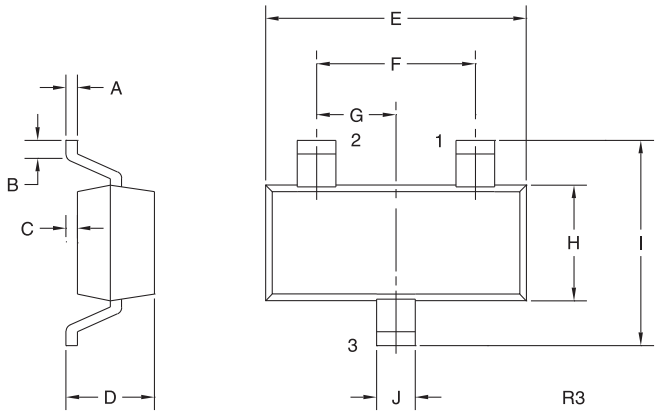
♦ Enhanced specification
♦♦ Additional Enhanced specification

R3 (27-January 2010)

CMPSH-3E
CMPSH-3AE
CMPSH-3CE
CMPSH-3SE

ENHANCED SPECIFICATION
SURFACE MOUNT
SILICON SCHOTTKY DIODES

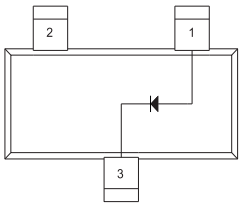
SOT-23 CASE - MECHANICAL OUTLINE



DIMENSIONS				
	INCHES		MILLIMETERS	
SYMBOL	MIN	MAX	MIN	MAX
A	0.003	0.007	0.08	0.18
B	0.006	-	0.15	-
C	-	0.005	-	0.13
D	0.035	0.043	0.89	1.09
E	0.110	0.120	2.80	3.05
F	0.075		1.90	
G	0.037		0.95	
H	0.047	0.055	1.19	1.40
I	0.083	0.098	2.10	2.49
J	0.014	0.020	0.35	0.50

SOT-23 (REV: R3)

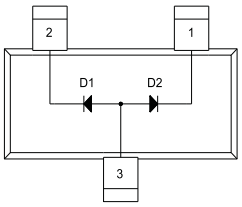
PIN CONFIGURATIONS



CMPSH-3E

LEAD CODE:
1) Anode
2) No Connection
3) Cathode

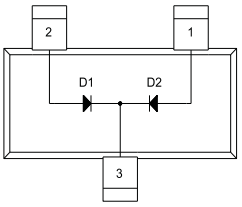
MARKING CODE: D95E



CMPSH-3AE

LEAD CODE:
1) Cathode D2
2) Cathode D1
3) Anode D1, D2

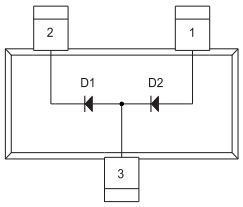
MARKING CODE: DB1E



CMPSH-3CE

LEAD CODE:
1) Anode D2
2) Anode D1
3) Cathode D1, D2

MARKING CODE: DB2E



CMPSH-3SE

LEAD CODE:
1) Anode D2
2) Cathode D1
3) Anode D1, Cathode D2

MARKING CODE: DA5E

Общество с ограниченной ответственностью «МосЧип» ИНН 7719860671 / КПП 771901001
Адрес: 105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

http://moschip.ru/get-element

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:
moschip.ru
moschip.ru_4
moschip.ru_6
moschip.ru_9